

Silicon NPN Transistor

S629T

400V / 500mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1989

S 627T · S 628T · S 629T

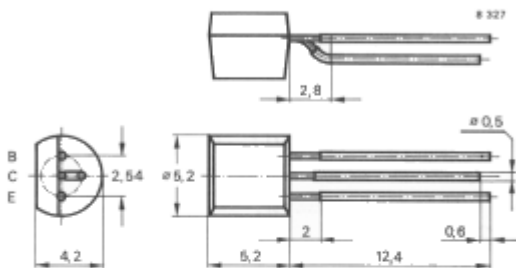
Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Allgemein bei hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:

- Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm



Standard Kunststoffgehäuse
10 A 3 DIN 41 868
JEDEC TO 92Z
Gewicht max. 0,5 g

Absolute Grenzdaten

		S 627T	S 628T	S 629T	
Kollektor-Basis-Sperrspannung	U_{CBO}	300	350	400	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	U_{CEO}	250	300	350	V
Emitter-Basis-Sperrspannung	U_{EBO}		8		V
Kollektorstrom	I_C		500		mA
Gesamtverlustleistung $T_{case} \leq 25^\circ\text{C}$	P_{tot}		1		W
Sperrschichttemperatur	T_j		150		$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}		-55 ... +150		$^\circ\text{C}$

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung $l \leq 3$ mm, auf Kupferkühlfläche	R_{thJA}	156			K/W
10 mm x 10 mm mit 35 μm Dicke	R_{thJA}	125			K/W
Sperrschicht-Gehäuse	R_{thJC}	55			K/W

S 627 T · S 628 T · S 629 T

Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.
$T_{amb} = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben				
Kollektorreststrom				
$U_{CES} = 150\text{ V}$				50 nA
$U_{CES} = 150\text{ V}, T_{case} = 150\text{ °C}$				100 μA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung				
$I_C = 1\text{ }\mu\text{A}$	S 627 T	$U_{(BR)CBO}^{1)}$	300	V
	S 628 T	$U_{(BR)CBO}^{1)}$	350	V
	S 629 T	$U_{(BR)CBO}^{1)}$	400	V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung				
$I_C = 1\text{ mA}$	S 627 T	$U_{(BR)CEO}^{1)}$	250	V
	S 628 T	$U_{(BR)CEO}^{1)}$	300	V
	S 629 T	$U_{(BR)CEO}^{1)}$	350	V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung				
$I_E = 1\text{ }\mu\text{A}$		$U_{(BR)EBO}$	8	V
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis				
$U_{CE} = 15\text{ V}, I_C = 50\text{ mA}$		h_{FE}	30	
$U_{CE} = 15\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}$		h_{FE}	50	

¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0,01, t_p = 0,3\text{ ms}$